PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43) Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number: 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

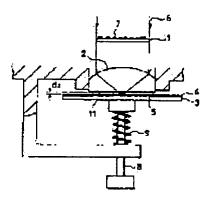
MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic- treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic-treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic-treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特計庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平4-305917

(43)公開日 平成4年(1992)10月28日

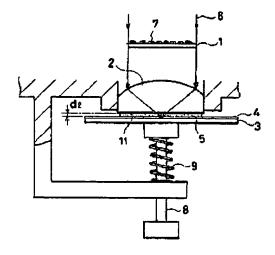
(51) Int CI. ⁵ H 0 1 L 21/027	綠別配号	庁内整理番号	FJ		技術表示箇所	
		7018—4 <u>M</u> 7352—4M	H01L	•	341 S 311 A	
			!	審查請求 未請求	苗求項の数1(全 3	贾)
(21) 出脚番号	特膜平3-94863		(71)出願人	000004112 株式会社ニコン		
(22)出頭日	平成3年(1991)4	月2日	(72)発明者	東京都千代田区 大関 尚夫	丸の内3丁目2番3号 大井一丁目6番3号 を	龙
			(72) 兖明者	••	大井一丁目6番3号 複製作所内	朱式
			(74)代理人	弁理士 山川 (攻 嵩	

(54) 【発明の名称】 密着型電光接直

(57) 【要約】

【目的】 密着型爾光袋籠において、浸液の膜厚を薄く して光の吸収量を少なくし、露光ムラを軽減防止するこ とを目的とする。

【構成】 超光レンズの密制面 1 1 をアルコール等の親 水溶液によって親水化処理する。この親水化処理された 密着面 1 1 にフォトレジスト 4 を整布されたウエハ3 を 浸液 5 を介して密着させ、照射光 6 の無射によりフォト マスク 1 のパターン7 をウエハ3 上に転写する。親水化 処理された密着面 1 1 は、吸水性が向上し、浸液 5 の膜 厚を薄くする。



(2)

特開平4-305917

【特許請求の範囲】

【請求項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八密帝国を額水化処理し、この親水化処理された密帝国 にフォトレジストを盤布されたウエハを浸液を介して密 着させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを 前紀フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密着型展光装団。

I

【発明の詳細な説明】

[0001]

【座業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に役割席光 する露光裏包、特に密着型露光被置に関するものであ る.

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体基板上に投影器光するこの類の露光袋間における路光 方式としては、①密着(コンタクト)電光方式、②プロ キシミティ國光方式、③反射型投影國光方式、④縮小レ ンズ投影解光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着露光方式は、フォトマスク (または投影光学系)とウェハとを密着させて観光する もので、これらが完全に告着している場合には、フォト レジスト中の波長が屈折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密菪を実現することは経 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に診 触させているためにウエハ表面の突起等によりフォトマ スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩留りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、密着爾光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に被体 (浸酸)を充填している。图2は投影光学系にウエハを 管着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は 投影光学系の一部を構成する超光レンズ、3はフォトレ ジスト4が弦布されたウエハ、5は露光レンズ2とウエ ハ3間に充填された浸液、6はフォトマスク1のパター ン?を照射しフォトレジスト4を開光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 である。 照射光 6 の波長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 装置が用いられる。 侵渡5としては、風折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を溶かさないものが望ましく。 過常純水が使用 される。

[0005]

【発明が修決しようとする課題】しかしながら、上述し たような浸被5を使用した密着型像光线圏においては、

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト電光されたフ オトレジスト4のパターンが的確に態光されている部分 とそうでない部分とが至じてしまうという問題があっ た。したがって、このような露光ムラの発生を防止する ため、投被5の赎厚d1 を薄くし、光の吸収ムラを少な くすることが望まれている。

【0006】本発明は上途したような従来の問題点およ び要望に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、浸液の膜厚を導くし、露光ムラを軽減防止し得るよ うにした密着型部光裳匿を提供することにある。

[0007]

【疎風を祭決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウェハ密 着面を親水化処理し、この親水化処理された密着面にフ オトレジストを塗布されたウェハを浸液を介して密管さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記 フォトレジストに転写するようにしたものである。

[0008]

【作用】本発明において、親水化処理された投影光学系 もしくはフォトマスクのウエハ密着画は、吸水性が向上 し、疫液の膜原を薄くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型露光装置の 一実施何を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一構成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハを密 着させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一部を構成する露光レンズ2のウエハ密着面11を予め 30 親水化処理し、この親水化処理された密岩面11にウエ ハ3を純水等の浸統5を介して密着させ、照射光6の展 射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転 写するようにしたものである。

【0010】 類水化処理は、アルコール系等の類水溶液 で密着面11を奇麗に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる、そして、この親水化処理後密着面11 にウエハ3を授掖5を介して密着させ、ウエハ3を露光 レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】かくしてこのような構成においては、親水 レウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 化処理によって密着面11の吸水低を向上させているの で、親水化処理を施さなかったときと比較して浸液5の 吸水効果が大きく、したがって、浸液5の表面張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、浸散5の態厚は2 を図 2に示した従来装置と比較して薄くする (d2 くd1) ことができ、また膜原が薄くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、軽光 ムラを軽減防止することができる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密着型 没被 5 自身の順厚ムラがあると、没被 5 による照射光 6 50 露光装置によれば、投影光学系またはフォトマスクのウ

-98-

(3)

特開平4-305917

エハ密着面を親水化処理し、この親水化処理された密着 面に、フォトレジストを整布されたウエハを侵波を介し て密着させるように構成したので、浸液自身の表面張力 を減らして濡れ性を向上させることができる。したがっ て、没被の順厚を薄くするができ、また膜厚が薄くなれ ば没被の誤算ムラも少なくなるため、光の吸収が少な く、浸液による露光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

【四1】本発明に係る密着型露光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。

【図2】密着型離光装配の従来例を示す妥略の新面図で

& 5.

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 課光レンズ
- ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 浸液
- 6 殿射光
- 7 マスク
- 10 11 密着面

